



# GEMaC

Groupe d'Étude  
de la Matière Condensée

## MOCVD DES SEMICONDUCTEURS II-VI

Le GEMaC possède deux bâtis de croissance MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) dédiés à la croissance de structures à base de semi-conducteurs II/VI.

### Bâti à réacteur horizontal (SAT)

Principales caractéristiques du bâti :

Sources :

- Eléments II : Zn, Mg, Cd
- Elements III : Ga
- Eléments VI : N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, t-butanol
- Dopage : Al, Ga, Sb, NH<sub>3</sub>

Gaz vecteur : He, H<sub>2</sub>, Ar, N<sub>2</sub>

Pression : 30 torr P. atmosphérique

Température : chauffage RF 1000°C

Taille des substrats : jusqu'à 2x2"



## Bâti à réacteur vertical

Principales caractéristiques du bâti :

Sources

- Eléments II : Zn, Mg
- Eléments VI : N<sub>2</sub>O, t-butanol, Se, Te, S
- Dopage : Al, Ga

Gaz vecteur : He, H<sub>2</sub>, Ar, N<sub>2</sub>

Pression : atmosphérique

Température : chauffage RF 1000°C

Taille des substrats 1 à 2 cm<sup>2</sup>



